



第 12 回窒化物半導体応用研究会のご案内

～知的クラスター成果報告、福岡クラスター活動紹介、 および窒化物半導体応用について～

主催：(公財) 科学技術交流財団

共催：(財) 福岡県産業・科学技術振興財団

協賛：(社) 応用物理学会東海支部、(財) 名古屋産業振興公社(予定)

後援：知的クラスター地域実用化協議会

日時 ■ 平成23年11月10日(木) 13:30～17:00(開場12:45)
会場 ■ 名古屋大学 IB電子情報館大講義室(名古屋市千種区不老町)
定員 ■ 200名(参加無料)

本地域は、GaNをはじめとする窒化物半導体発祥の地であります。半導体産業としては、今日までSi半導体を中心でしたが、地球温暖化問題等で環境・エネルギー対策として、窒化物半導体が脚光を浴びてきました。窒化物半導体を用いることで低消費電力照明として大きな市場が期待されているLED、Si半導体ではなかなか達成が難しかった高周波デバイスや高耐圧パワーデバイス、紫外線センサーや滅菌・殺菌装置などの新しい世界が広がります。窒化物半導体発祥の当地域において、窒化物半導体産業の技術開発の現状や応用等、より多くの窒化物応用に積極的に携わる企業や大学の研究者への情報交換、周知等も含めたシナジー効果と近分野の交流を図る狙いです。特に今回は、当東海広域ナノテクものづくりクラスター事業と関係が深く半導体デバイスの設計・応用について研究を進めている福岡クラスターにお越し頂き、お互いの最新成果報告を行うとともに国内の研究者から窒化物半導体の応用に関する最新情報をお届けします。ぜひこの機会に、窒化物半導体についてもっと知りたい、窒化物半導体を利用した製品を開発したい、窒化物半導体の応用に積極的に関わりたい、という企業や大学の研究者の方々にお集まりいただきたく、ご参加をお待ちしております。

研究会プログラム

※都合により内容、時間に変更になる場合があります。

○開会挨拶 13:30-13:35

東海広域知的クラスター創成事業本部 事業総括 大塚 美則

◆ 講演 ◆

○第1部 知的クラスター事業成果の紹介

①13:35-14:00 「次世代自動車用高出力パワーデバイス、高周波デバイスの開発」

名古屋工業大学 教授 江川 孝志氏

②14:00-14:25 「低消費電力高輝度高演色性LED、環境対応モニタリング用センサーの開発」

名古屋大学 教授 天野 浩氏

③14:25-14:50 「窒化物半導体デバイスプロセス、インテリジェントデバイスの開発と試作体制の整備」

豊橋技術科学大学 教授 若原 昭浩氏

○第2部 福岡クラスター事業の紹介

④14:50-15:10 「福岡先端システムLSI開発クラスターの取組」

(財)福岡県産業・科学技術振興財団 イノベーションクラスター戦略本部 副事業総括 力武 知嗣氏

⑤15:10-15:30 「三次元半導体研究センターの取組」

(財)福岡県産業・科学技術振興財団 三次元半導体研究センター 主幹研究員 野北 寛太氏

<休憩 20分間>

○第3部 GaN電子デバイスの可能性について

⑥15:50-16:20 「ノーマリーオフ型 GaNHFETの高性能化」

NTTフォトニクス研究所 前田 就彦氏

⑦16:20-16:50 「Si基板上ノーマリーオフ AlGaIn/GaNハイブリッドMOS-HFETの高耐圧化」

次世代パワーデバイス技術研究組合 池田 成明氏

○まとめ 16:50-17:00

◆ 懇親会 ◆ 17:15～18:30 (有料・会費制 ¥3,000)

○会場： 名古屋大学 シンポジオン2F(豊田講堂東) レストラン「ユニバーサルクラブ」

○会費： ¥3,000 ※当日受付時にお支払いください。

《参加申込み方法：電子メール受付》 ⇒ 申込み先：cluster2008@astf.or.jp

◆ 研究会メンバーの方

研究会及び懇親会の各出欠について、ご連絡をお願いします。

(メールの件名を「窒化物半導体応用研究会参加申込」としてください。)

◆ 初めてご入会、ご参加される方

研究会メンバーにご入会の上、研究会及び懇親会にお申込みください。

(メールの件名を「窒化物半導体応用研究会入会希望」としてください。)

①お名前 ②会社名(所属先) ③ご住所 ④お電話番号 ⑤メールアドレス

⑥研究会メンバーリストへの掲載可否(お名前と団体名のみ掲載いたします。)

◆ これまでの研究会の発表◆

- 第1回：当地域大学より、研究室の概要、研究体制・人員、研究設備、研究テーマや産学連携の成果等発表。
- 第2回：知的クラスターで今後連携を検討している大学、名古屋工業大学江川教授と共同研究を実施している企業からの発表。
- 第3回：光デバイスを中心に、ベンチャー企業、今後連携を検討している大学からの発表。
名城大学の光デバイス研究設備の見学。
- 第4回：高速電子デバイス、パワーデバイスを中心に、公的機関、企業、大学からの発表。
名古屋工業大学の極微デバイス研究設備の見学。
- 第5回：窒化物半導体のインテリジェント化、将来の窒化物半導体試作を中心に、大学、企業からの発表。
豊橋技術科学大学の1300 m²デバイスプロセスクリーンルームの見学。
- 第6回：窒化物半導体のメッカ名古屋大学にて、大学、国内外の企業からの発表。赤崎記念研究センター、窒化物半導体研究室、プラズマナノ工学研究センターの見学。
- 第7回：白色LEDに的を絞り、世界の白色LEDの開發現状、応用開発、周辺技術に関して企業、大学より発表。
- 第8回：低コストGaN/Si系パワーデバイス・電子デバイスに関する最先端の開発状況を企業、大学より発表。
- 第9回：GaNバルク基板、紫外光デバイスに関する最先端の開発状況について企業、大学より発表。
- 第10回：世界の窒化物半導体の開発動向について、国内外の企業、大学、公設施より発表。
- 第11回：知クラ成果の紹介と参加企業からの新技術情報の紹介

[窒化物半導体応用研究会事務局]

公益財団法人科学技術交流財団 東海広域知的クラスター創成事業部(担当 長、伊藤)

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目4-7 愛知県産業貿易館西館7階

TEL:052-231-1656 FAX:052-231-1640

E-mail: cluster2008@astf.or.jp

名古屋大学
キャンパスマップ

